

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0111U005422

Відкрита

Дата реєстрації: 29-06-2011

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

КПКВК: 5031080

Напрямок фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2100

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2011	2100

2. Замовник

Назва організації: Державне агентство з питань електронного урядування України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 37471818

Адреса: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів

Телефон: 2071730

WWW: <http://e.gov.ua>

3. Виконавець

Назва організації: Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23273999

Підпорядкованість: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Адреса: вул. Стрийська, 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Телефон: 2631065

E-mail: office@carat.electron.ua

4. Співвиконавець

Назва організації: Державний науково-дослідний центр "Фонон"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 13675648

Адреса: , м. Київ, Київ, 03056, Україна

Підпорядкованість: Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності

Телефон: 246-38-11

Інше: 246-38-11

Назва організації: Закрите акціонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Наука"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 25594064

Адреса: , м. Київ, Київ, 03148, Україна

Підпорядкованість: Держадміністрація

Телефон: 246-38-16

Інше: 246-38-11

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

"Розроблення фізико-хімічних основ технології отримання наноструктур для НВЧ-приладів з використанням модифікуючого впливу рідкоземельних елементів"

Назва роботи (англ)

"Development of physical and chemical bases of nanostructures obtaining technology for НВЧ devices using modifying influence of rare earth elements"

Мета роботи (укр)

Розроблення фізико-хімічних основ технології виготовлення епітаксійних структур на основі InP для діодів Гана, на нанопористих підкладах, методом газофазної трихлоридної епітаксії з використанням очистки газових сумішей сильно розвиненою металевою поверхнею, активованою ізовалентними металами та рідкоземельними елементами.

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: Електронне приладобування

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	06.2011	12.2011	Остаточний звіт	Відпрацювання технології нарощування епітаксійних структур n-InP/n+-InP/n++-InP на поверхні нанопористих підкладок під впливом рідкоземельних елементів та дослідження їх парметрів. Розроблення рекомендацій щодо застосування результатів НДР.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 45.47.02

Індекс УДК: 621.315.1/.3, 621.315

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Ваків Микола Михайлович (д. т. н., професор)

Керівники роботи:

Круковський Семен Іванович

Відповідальний за подання документів: (Тел.:)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.